



	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD530N15N3GBTMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 21A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD530N15N3GBTMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	IPD530N15N3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 21A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 35µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	53 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	887pF @ 75V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

IPD530N15N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD530N15N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD530N15N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPD530N15N3GBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD530N15N3 G</b> V IPD530N15N3 G V</p>	 <p><b>IPD530N15NG</b> V IPD530N15NG V</p>	 <p><b>IPD530N15N3G</b> I IPD530N15N3G I</p>	 <p><b>IPD5N03LAG</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A TO252-3-11</p>
 <p><b>IPD600N25N3 G</b> INFINEON IPD600N25N3 G INFINEON</p>	 <p><b>IPD600N25N3G</b> INFINEON IPD600N25N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPD50R950CEBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 500V 4.3A PG-TO252</p>	 <p><b>IPD530N15N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 21A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD530N15N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD530N15N3GBTMA1 Datenblatt	IPD530N15N3GBTMA1-Datenblätter	IPD530N15N3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD530N15N3GBTMA1
IPD530N15N3GBTMA1 Electronic	IPD530N15N3GBTMA1-Komponenten	IPD530N15N3GBTMA1-Verteiler	IPD530N15N3GBTMA1-Bild	IPD530N15N3GBTMA1-Teil
IPD530N15N3GBTMA1 Preis	IPD530N15N3GBTMA1 Hersteller	IPD530N15N3GBTMA1 Bild	IPD530N15N3GBTMA1 Aktie	IPD530N15N3GBTMA1 Inventar
IPD530N15N3GBTMA1 Neu	IPD530N15N3GBTMA1 Original	IPD530N15N3GBTMA1 garantiert	IPD530N15N3GBTMA1 RFQ	IPD530N15N3GBTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited